

§ 微電子所博士班規則

1. 微電子工程研究所博士班規則(以下簡稱本規則)依本校教務規章規則訂定之。

2. 入學要求：筆試、口試及審查。

3. 學分制度：

(1)依教育部有關法令辦理。

(2)不得再修入學前已修過相同科目名稱之課程。

(3)畢業學分之承認依電機系相關規定辦理。

4. 資格考試：與電機系合併辦理。

(1) 資格考試共選考本所四科；科目如電機工程學系博士班規則第 9 點。若擬以國際權威期刊且為第一作者(指導教授外)之論文乙篇抵免一科，國際權威期刊原則上為 4 點(含)以上之期刊(如附件)，且經所務會議同意始得抵免，該抵免論文不得列入相關作者之畢業點數。

(2) 時間及次數：每學期舉辦一次。各研究生於第一次參加考試時，必須決定全部選考科目，選定之後得更換一科(但考試次數累計)。每科考試次數以四次為限，但應於入學兩年內完成為原則，至多不得超過五年。未依規定年限或次數完成者，由本所通知註冊組勒令退學。資格考試及格後之下一學期方准申請畢業論文口試(已達最後修業期限者可於當學期提出)。

5. 論文初審：由指導教授向本所申請開會審查，至少須本所專任教師五人(含)以上出席，並經出席者三分之二(含)以上投票通過，向電機系學術委員會報備後，才能辦理論文口試。申請時必須提出論文相關資料，包括發表論文之計點認定說明，修業年限及是否兼職，兼職者修業年限不得少於三年。

6. 發表論文之計點辦法：

(1)論文必須以成功大學電機系，微電子工程研究所(Institute of Microelectronics, Department of Electrical Engineering, National Cheng Kung University)名義發表，否則不予計點。

(2) 有下列情況之一者，不列入計點：

a. 所發表之論文與畢業論文不相關者。

b. 非以本所及電機系為成果所屬機構者。

c. 第一作者之所屬機構未註明為本所及電機系者。

(3)除碩士班直升博士班外，以碩士論文所發表之論文，不予計點。但若以碩士論文為基礎進行擴充性之研究，不在此限。

(4)若有兩篇(或以上)論文疑似重疊時，其重疊率平均值高於 50%，除符合第 6 條第(5)款或第(6)款者外，則只計一篇之計點。

(5)若重疊論文中，一為會議論文，一為期刊論文，前者只計一半，後者全數計算，但若為附件一所列之重點會議論文則不在此限。

(6)若所投稿為重點會議論文，則期刊與重點會議之點數全數計算。

7. 期刊點數規定：

(1)期刊(Journal)

分為頂級、重點、第 1、第 2 及第 3 類期刊論文，其計點數如附件所示。

(2)會議(Conference, Symposium):重點會議(如附件)4 點，其他國際會議 0.6 點，國內會議 0.4 點。重點會議論文計點總數不受篇數限制，其他會議論文之計點總數不得超過 1 點。其中會議必須具備完整審查制度，並刊印有論文集之一流學術會議者。

8. 計點辦法：

(1)除指導教授外，排名第一者，以全分計算，第二者以 1/2 計算，第三名以 1/4 計算，第四名(含)以後者不計點。

(2)每篇論文僅能供一位研究生申請計點。

9. 博士班候選人申請畢業論文必須至少擁有 6 個積點(積點採四捨五入，取至小數第二位)，且至少須有一篇 first

89/07/18 所務會議通過

91/12/03 所務會議修訂

94/05/26 所務會議修訂

94/10/24 所務會議修訂

102/11/13 所務會議修訂

103/06/06 所務會議修訂

author 之期刊論文。

10. 畢業之最低點數：

二年畢業：14 點且須包含頂級或重點期刊之全文論文至少 3 篇。

三年畢業：10 點且須包含頂級或重點期刊之全文論文至少 2 篇。

四年畢業：8 點且須包含頂級或重點期刊之全文論文至少 1 篇。

五年畢業：6 點且須包含重點或第 1 類期刊之全文論文至少 1 篇。

六年(含)以後畢業：6 點且須包含期刊全文論文至少 1 篇。

11. 博士論文口試：

(1)研究成果必須具有創造性及完整性,並須寫成論文。

(2)口試委員組織：

依研究生學位考試規則規定,由 5~9 位委員組成。校外委員須超過三分之一,指導教授為當然委員,由校長指定一人為召集人主持之。校內外委員資格依規定辦理。

(3)口試後立即由口試委員無記名投票,超過三分之二(含)通過,方為通過。

(4)投票通過後,由口試委員評定分數,口試成績以 100 分為滿分,70 分為及格,論文成績以各口試委員評定之平均分數決定之。

(5)口試委員不得委託其他委員或非委員。

12. 本規則自通過日後開始實施。通過日之前入學者,得選擇修正前或修正後規則辦理。

附件

一、 頂級期刊,計點數:8。

1. Nature
2. Science
3. 影響係數 (Impact Factor) 值大於 7.0 之優質期刊。

二、 重點期刊,計點數:4。

1. Applied Physics Letters
2. IEEE Electron Device Letters
3. IEEE Journal of Quantum Electronics
4. IEEE Transactions on Electron Devices
5. IEEE Photonic Technology Letters
6. IEEE Sensors Journal
7. IEEE Transactions on Nanotechnology
8. Journal of Applied Physics
9. Journal of Lightwave Technology
10. Journal of the Electrochemistry Society
11. Physics Review B
12. Physics Review Letters
13. Sensors and Actuators B-Chemical
14. 其他影響係數值大於 2.0 之優質期刊。

三、 第 1 類期刊,計點數:3。

1. IEEE Transactions on Advanced Packaging
2. IEEE Transactions on Components and Packaging Technologies
3. Transactions of the ASME, Journal of Electronic Packaging
4. IEEE Transactions on Device and Materials Reliability
5. 其他影響係數值介於 1.5 至 2.0 之優質期刊。

四、第2類期刊，計點數：2。

本類期刊係指影響係數值介於0.8至1.5間之優質期刊。

五、第3類期刊，計點數：1。

本類期刊係指非上述所列舉之優質期刊。

六、上述各期刊論文之計點數係以全文論文（Full Paper）為標準，若為短文論文（如 Brief, Note...等）則該篇論文之計點數將以折半計算。

七、上述各期刊之影響係數值，係指博士班研究生申請畢業時，該期刊近三年內影響係數之平均值。若有期刊其影響係數在博士班研究生申請畢業時被取消，該期刊之論文是否可以計點以論文投稿時該期刊是否仍有影響係數為依據，若論文投稿時該期刊仍有影響係數則可計點，其影響係數值以取消前最後三年內影響係數之平均值計算。

八、重點會議名稱（計點數：4）

1. IEEE International Electron Device Meeting (IEDM)
2. IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC)
3. IEEE Device Research Conference (DRC)
4. IEEE Compound Semiconductor Integrated Circuits Symposium.
5. VLSI Symposia
6. International Interconnect Technology Conference (IITC)